



**FACULTAD
DE INGENIERIA**

Universidad de Buenos Aires

CIRCUITOS ELECTRÓNICOS II - 66.10
DISEÑO DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS - 86.10

Trabajo práctico final

Diseño y construcción de un amplificador clase G - mediciones

Alumnos:

LUNA Diego

diegorluna@gmail.com

NEUMARKT FERNÁNDEZ Leonardo Padrón N° 97471

leoneu928@gmail.com

RIZZO Gonzalo Gabriel

gonzalorizzo95@gmail.com

Padrón N° 75451

Padrón N° 97471

Padrón N° 96772

Docentes:

Ing. BERTUCCIO José Alberto

Ing. MARCHI Edgardo

Ing. BULACIO Matías

Ing. D'ANGIOLO Federico

Ing. GAMEZ Pablo

12 de Diciembre de 2019

Índice

Índice	I
1. Consideraciones previas al diseño	1
1.1. Objetivo y requerimientos de usuario	1
1.2. Especificaciones	1
2. Diseño circuital	2
2.1. Circuito Pre-amplificador	2
2.2. Fuente <i>Switching</i>	2
2.3. Circuito amplificador	4
3. Simulaciones	7
3.1. Polarización	7
3.2. Ganancia de lazo	9
3.3. Ancho de banda	11
3.4. Ancho de banda de potencia	13
3.5. Impedancias de entrada y salida	15
3.6. THD	18
3.7. Slew Rate	20
4. Mediciones	23
4.1. Polarización	23
4.2. Ancho de banda	25
4.3. Ancho de banda de potencia	28
4.4. Sensibilidad	30
4.5. THD	31
4.6. Slew Rate	31
5. Observaciones y conclusiones	34
6. Bibliografía	35
Apéndices	37
A. Hojas de datos	37
A.1. BD135	37
A.2. BD136	37
A.3. BC556	37
A.4. MJL21193	37
A.5. MJL21194	37
A.6. 1N4148	38
A.7. 1N4370	38
A.8. 1N4007	38

A.9. 1N5822	38
A.10.Metal film resistor	38
A.11.Carbon film resistor	38
A.12.Ceramic capacitor	39
A.13.Electrolitic Aluminum capacitor	39

Índice de figuras

2.1. Circuito pre-amplificador.	2
2.2. Circuito <i>Step Down</i>	3
2.3. Circuito <i>Step Up</i>	3
2.4. Vista 3D del PCB de la fuente switching interna.	4
2.5. Esquemático de amplificador con clase G.	5
2.6. PCB del amplificador.	6
2.7. Vista 3D del PCB del amplificador.	6
3.1. Circuito simulado mostrando los valores de polarización.	8
3.2. Ganancia de lazo (simulación).	10
3.3. Ancho de banda a baja potencia (simulación).	12
3.4. Ancho de banda de potencia (simulación).	14
3.5. Valores de impedancia de entrada (simulación).	16
3.6. Valores de impedancia de salida (simulación).	17
3.7. THD en función de la frecuencia (simulación).	18
3.8. THD en función de la potencia (simulación).	19
3.9. Tiempo de crecimiento (simulación).	21
3.10. Tiempo de crecimiento, zoom sobre la pendiente (simulación).	22
4.1. Medición de f_l a baja potencia, mostrando el corrimiento de fase.	26
4.2. Cálculo del corrimiento de fase para f_l a baja potencia.	27
4.3. Cálculo del corrimiento de fase para f_h a baja potencia.	28
4.4. Medición de f_l a máxima potencia, mostrando el corrimiento de fase.	29
4.5. Medición de f_l a máxima potencia, mostrando el corrimiento de fase.	30
4.6. Medición de la sensibilidad del circuito amplificador.	31
4.7. Verificación de tiempo de crecimiento del generador.	32
4.8. Medición del Slew Rate del circuito amplificador.	33

Índice de cuadros

3.1. Punto de reposo de los transistores y máxima potencia disipada en operación.	7
4.1. Primer punto de operación.	24
4.2. Segundo punto de operación.	24
4.3. Valores significativos del ancho de banda a baja potencia.	25
4.4. Comparación de ancho de banda a baja potencia	25
4.5. Valores significativos del ancho de banda a máxima potencia.	28
4.6. Comparación de ancho de banda a máxima potencia	29
4.7. Comparación del Slew Rate.	33

1. Consideraciones previas al diseño

1.1. Objetivo y requerimientos de usuario

El objetivo del presente trabajo es armar un circuito amplificador que amplifique una señal de audio que será reproducida en un Baffle (asumimos respuesta resistiva pura en todo el ancho de banda). Debe proveer al usuario con una buena calidad de sonido (algo subjetivo, no obstante acá solo se consideran medidas reales) con volumen alto, sin consumir mucha más energía de la necesaria, ni ser muy grande y pesado. Es decir, debe tener baja distorsión (THD), alta relación señal-ruido (SNR), eficiencia razonable y buena potencia máxima de salida.

1.2. Especificaciones

A continuación se enumeran las especificaciones que fueron tenidas en consideración para la implementación del amplificador de audio.

- Máxima Potencia de Salida: $\geq 40WRMS@8\Omega$
- Salida clase **G**
- THD: $< 0,1\%@1kHz$, $< 0,2\%@10kHz$, a $40WRMS@8\Omega$
- Slew-Rate: $> 5 \frac{V}{\mu S}$
- Impedancia de entrada: $> 21k\Omega$
- Sensibilidad: $1,1V \text{ pico } @8\Omega$
- Ancho de banda: $10Hz \rightarrow 50kHz$
- Factor de amortiguamiento: > 100
- Ancho de banda de potencia: $> 30kHz$
- Alimentación:
 - Baja tensión: $\pm 15V$ nominal (desde transformador de $10V + 10V$), ripple máximo 10%
 - Alta tensión: $\pm 35V$ nominal (desde fuente switching implementada de $15V + 15V$ más fuente de alimentación de $25V + 25V$), ripple máximo 10%
- Máxima excursión: 25V

2. Diseño circuital

2.1. Circuito Pre-amplificador

El circuito pre-amplificador consta de un integrado *TL072* con una configuración de realimentación paralelo-serie, que tiene como fin, amplificar la señal de entrada para ser tratada mediante los filtros siguientes al capacitor de acople C_{12} .

Los filtros tienen como fin disminuir el volumen de las frecuencias bajas o altas a modo de incluir una etapa de procesamiento de señal al proyecto. Esto se logra con los potenciómetros incluidos en la placa, para que el ajuste sea de fácil manejo.

Por último, se utiliza un divisor resistivo para controlar el volumen del amplificador en conjunto.

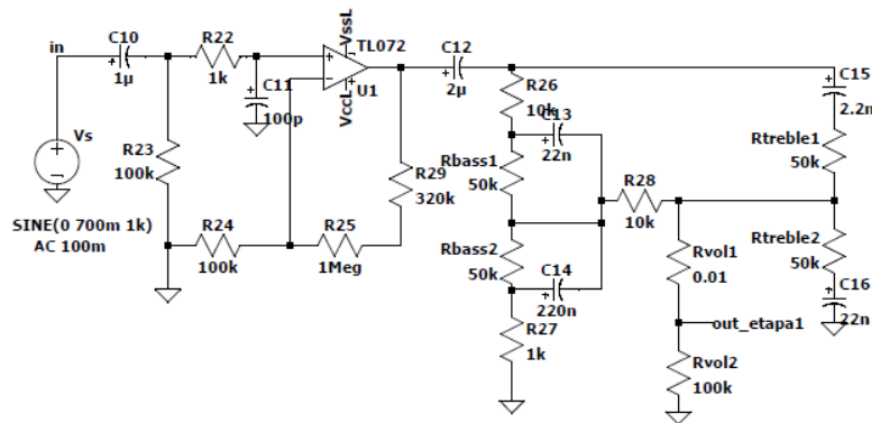


Figura 2.1: Circuito pre-amplificador.

2.2. Fuente *Switching*

El circuito amplificador se alimenta con 4 tensiones diferentes, las cuales son $+35V$, $+15V$, $-35V$ y $-15V$, para ello se diseñaron dos fuentes switching, una *step down* para bajar de $35V$ a $15V$ y una *step up* para subir de $-35V$ a $-15V$.

A partir de las hojas de datos de los reguladores **LM2576** y **LM2577**, en configuraciones indicadas para entregar las alimentaciones correspondientes. Se implementaron los siguientes circuitos tomados de las hojas de datos:

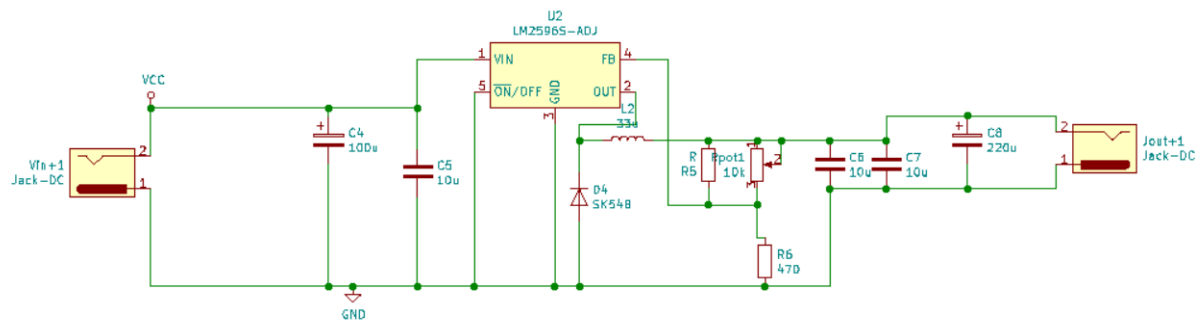


Figura 2.2: Circuito Step Down.

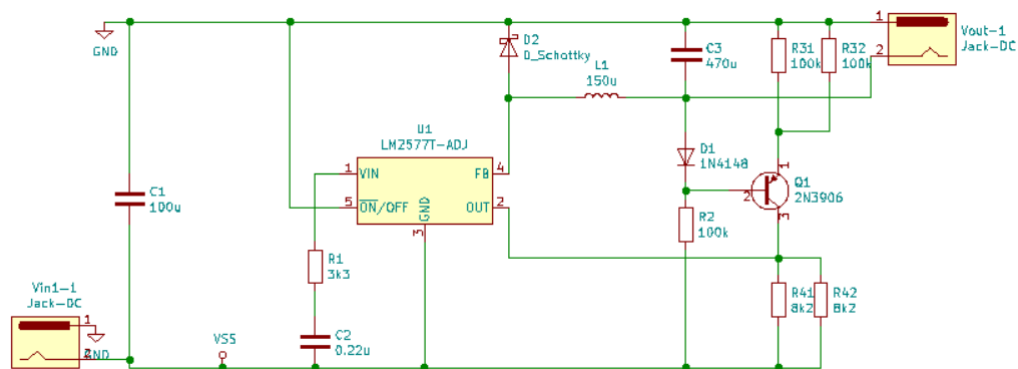
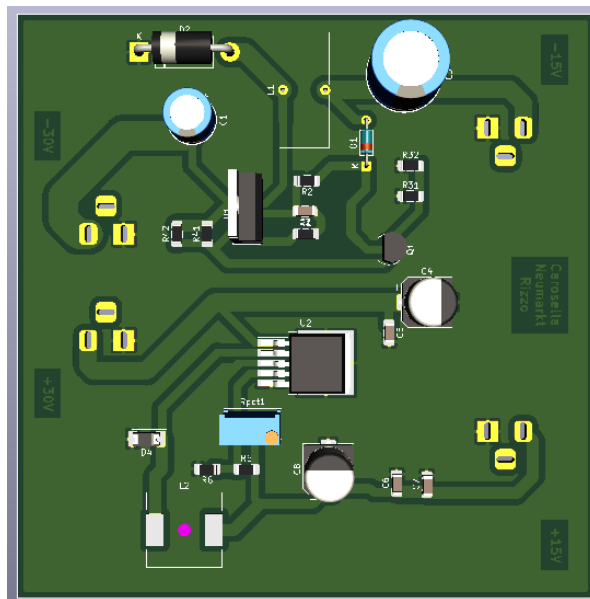
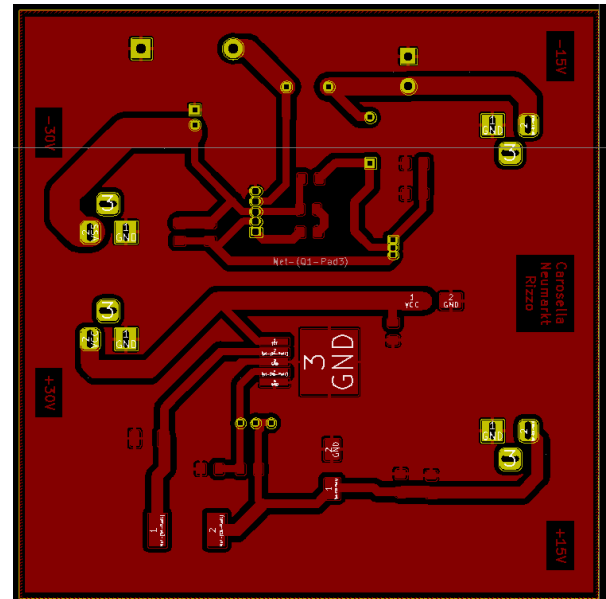


Figura 2.3: Circuito Step Up.

Luego se diseñó el PCB de la fuente *Switching* en *Kicad* a partir de los circuitos mencionados, el resultado se puede observar a continuación:



(a) Vista superior.



(b) Vista inferior.

Figura 2.4: Vista 3D del PCB de la fuente switching interna.

2.3. Circuito amplificador

A continuación, se muestran el esquemático del circuito implementado en *Kicad*. En primer lugar, en la figura [2.5] muestra el amplificador principal clase G diseñado junto con el circuito de pre-amplificador. Luego se prosiguió por realizar el diseño del PCB. Para ello se aplicó un plano de masa en la capa superior de la placa. Por otro lado se utilizaron pistas anchas y cortas, de un espesor de 60mils a 118mils y separaciones entre pistas mayores a 12mils. A continuación se muestran imágenes del PCB para el amplificador clase G a implementar:

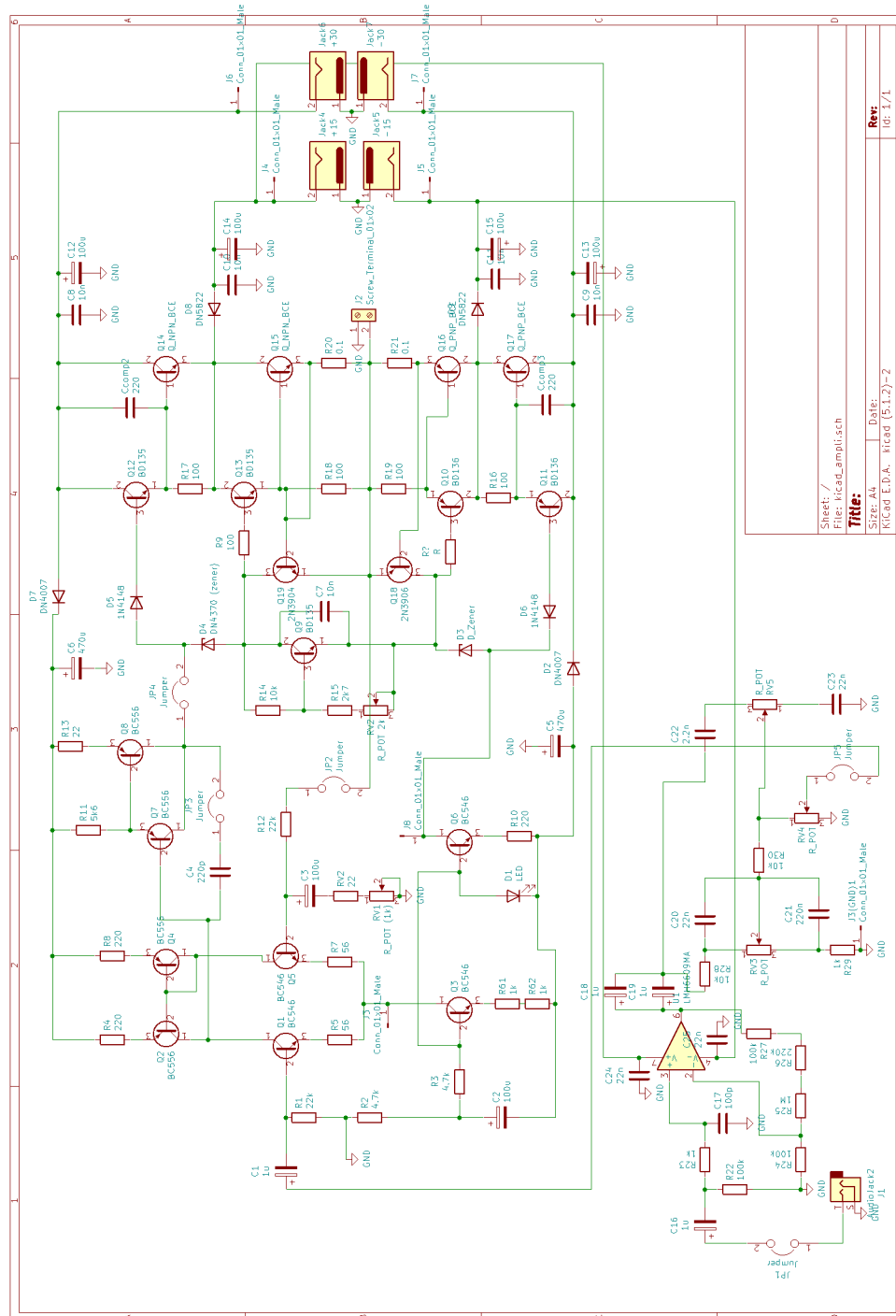


Figura 2.5: Esquemático de amplificador con clase G.

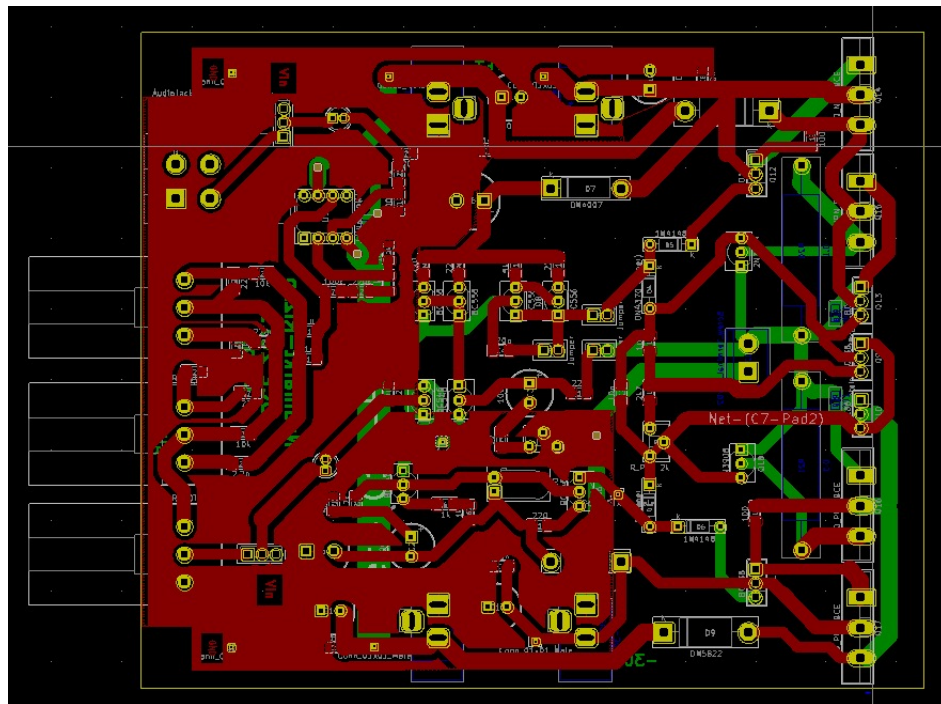
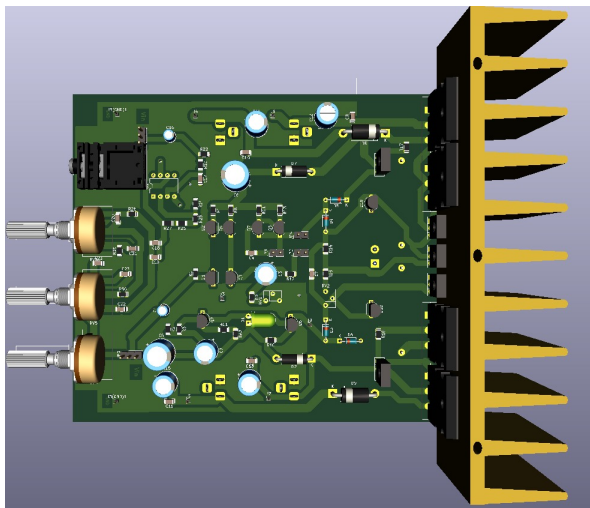
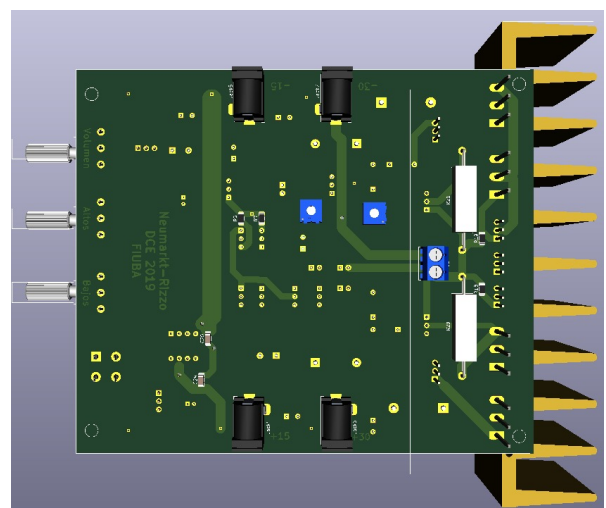


Figura 2.6: PCB del amplificador.



(a) Vista superior.



(b) Vista inferior.

Figura 2.7: Vista 3D del PCB del amplificador.

3. Simulaciones

3.1. Polarización

Se simularon los valores en reposo de los transistores de la etapa amplificadora clase G, junto con la máxima potencia disipada en cada uno. Los resultados se muestran en el cuadro [3.1]

Transistor	V_{BEQ}	V_{CEQ}	I_{CQ}	P_Q
Q_1 (BC546C)	612mV	33,87V	549μA	18,6mW
Q_2 (BC556B)	-610mV	-1,31V	549μA	722μW
Q_3 (BC546B)	631mV	31,78V	1,1mA	35mW
Q_4 (BC556B)	-610mV	33,78V	549μA	334mW
Q_5 (BC546B)	612mV	34,6V	549μA	19mW
Q_6 (BC546B)	693mV	28,8V	9,71mA	280mW
Q_7 (BC556B)	-557mV	30V	170μA	5mW
Q_8 (BC556B)	-669mV	30,71V	9,57mA	294mW
Q_9 (BD135)	676mV	2,96V	9,40mA	28mW
Q_{10} (BD136)	-722mV	13,9V	15mA	208mW
Q_{11} (BD136)	10,95V	20,32V	31pA	1,1anoW
Q_{12} (BD135)	-10,93V	20,32V	31pA	1,1anoW
Q_{13} (BD135)	693mV	13,88V	18,9mA	263mW
Q_{14} (MJL21194)	1,04mV	20,32V	26pA	522pW
Q_{15} (MJL21194)	722mV	14,6V	714mA	10,43W
Q_{16} (MJL21193)	-678mV	14,6V	718mA	10,49W
Q_{17} (MJL21193)	-986mV	20,32V	1,76pA	459pW
Q_{18} (2N3906)	-72mV	1,47V	1,47pA	2,2pW
Q_{19} (2N3904)	72mV	1,48V	1,58pA	2,3pW

Cuadro 3.1: Punto de reposo de los transistores y máxima potencia disipada en operación.

En la figura [3.1] se pueden verificar los resultados de la simulación con las referencias en el circuito pertinente.

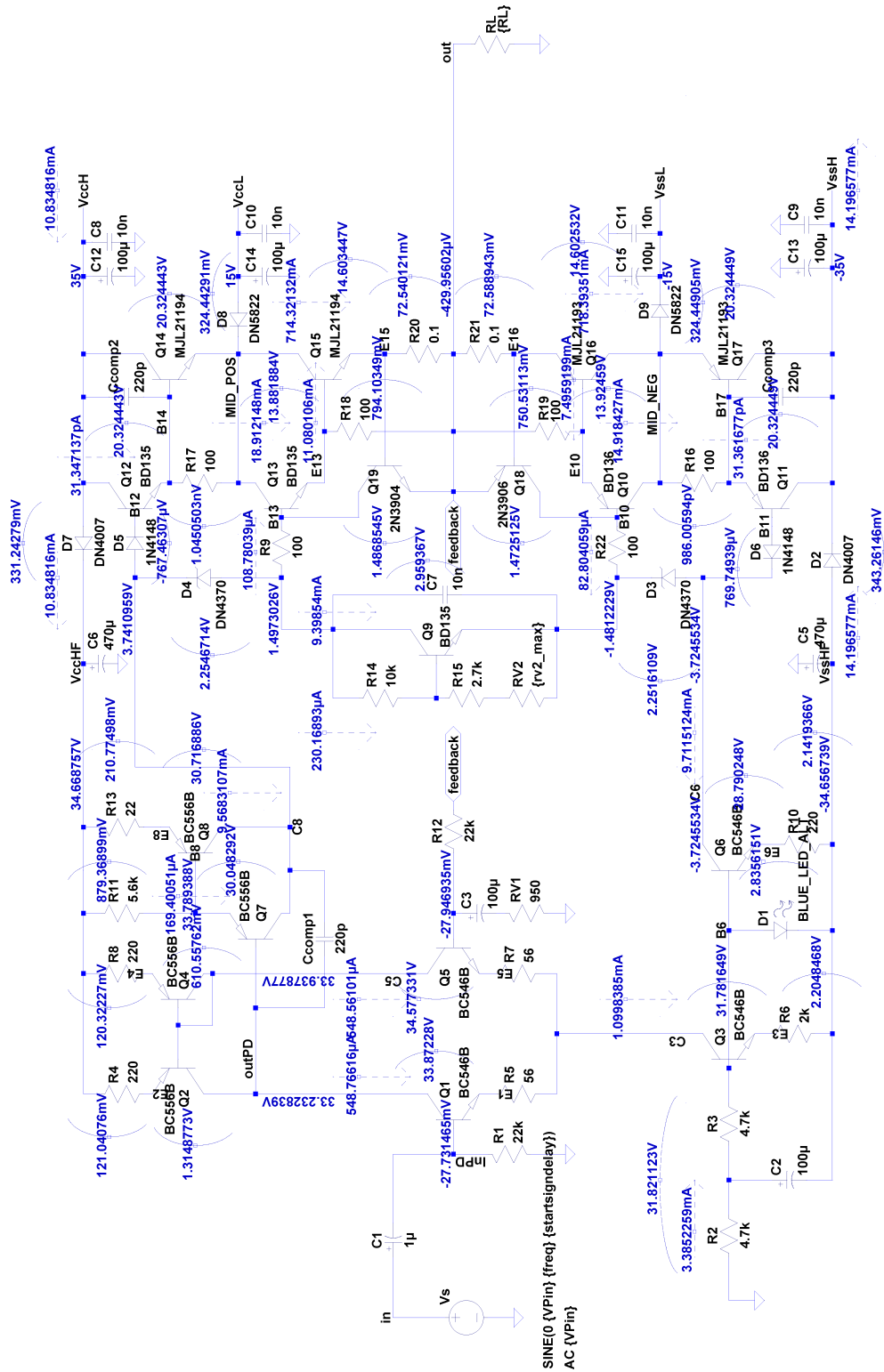


Figura 3.1: Circuito simulado mostrando los valores de polarización.

3.2. Ganancia de lazo

En la figura [3.2] se puede observar la ganancia de lazo del circuito, simulado a distintas frecuencias. A su vez, se especifica el margen de ganancia y de fase, para verificar la correcta estabilización del circuito. Obteniéndose de este modo:

- Margen de ganancia: 29,21dB
- Margen de fase: 86,12°

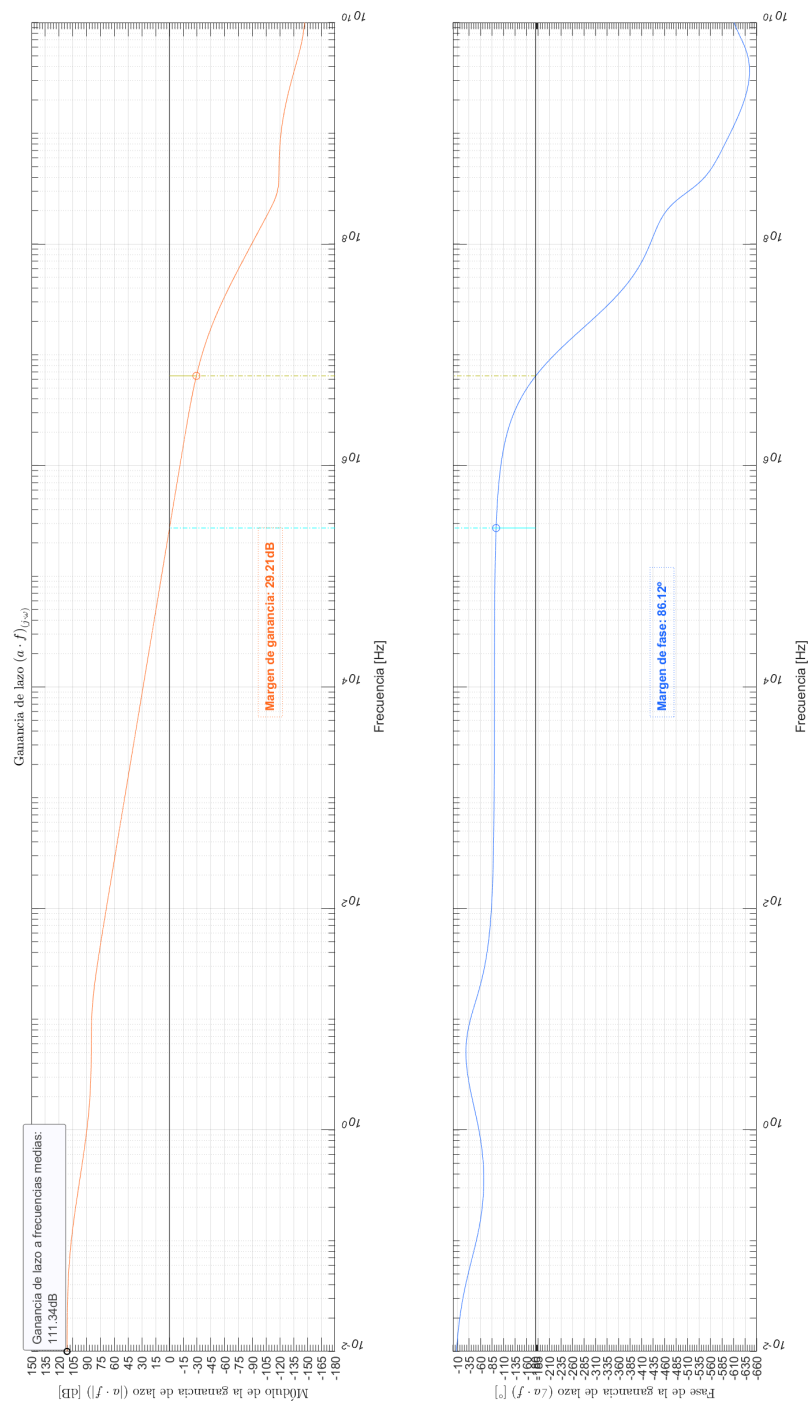


Figura 3.2: Ganancia de lazo (simulación).

3.3. Ancho de banda

En la figura [3.3] se muestra el resultado de la simulación del ancho de banda del circuito. Obtenemos un ancho de banda de $97,89kHz$ con frecuencias de corte:

- $f_l = 22,34Hz$
- $f_h = 97,92kHz$

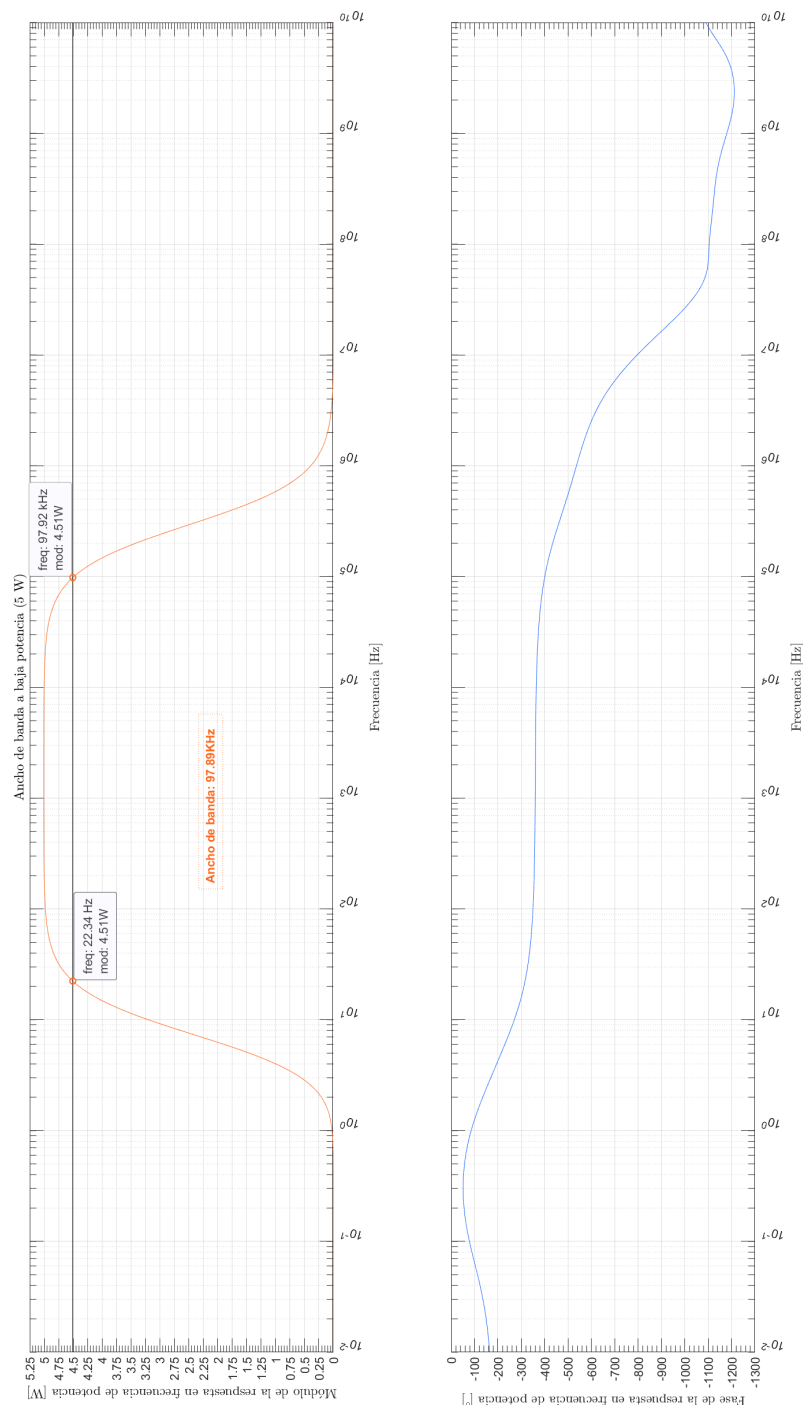


Figura 3.3: Ancho de banda a baja potencia (simulación).

3.4. Ancho de banda de potencia

En la figura [3.4], se observa el resultado de la simulación del ancho de banda de potencia simulado. Obtenemos en el circuito un ancho de banda de potencia de $97,89kHz$ con frecuencias de corte:

- $f_l = 22,34Hz$
- $f_h = 97,84kHz$

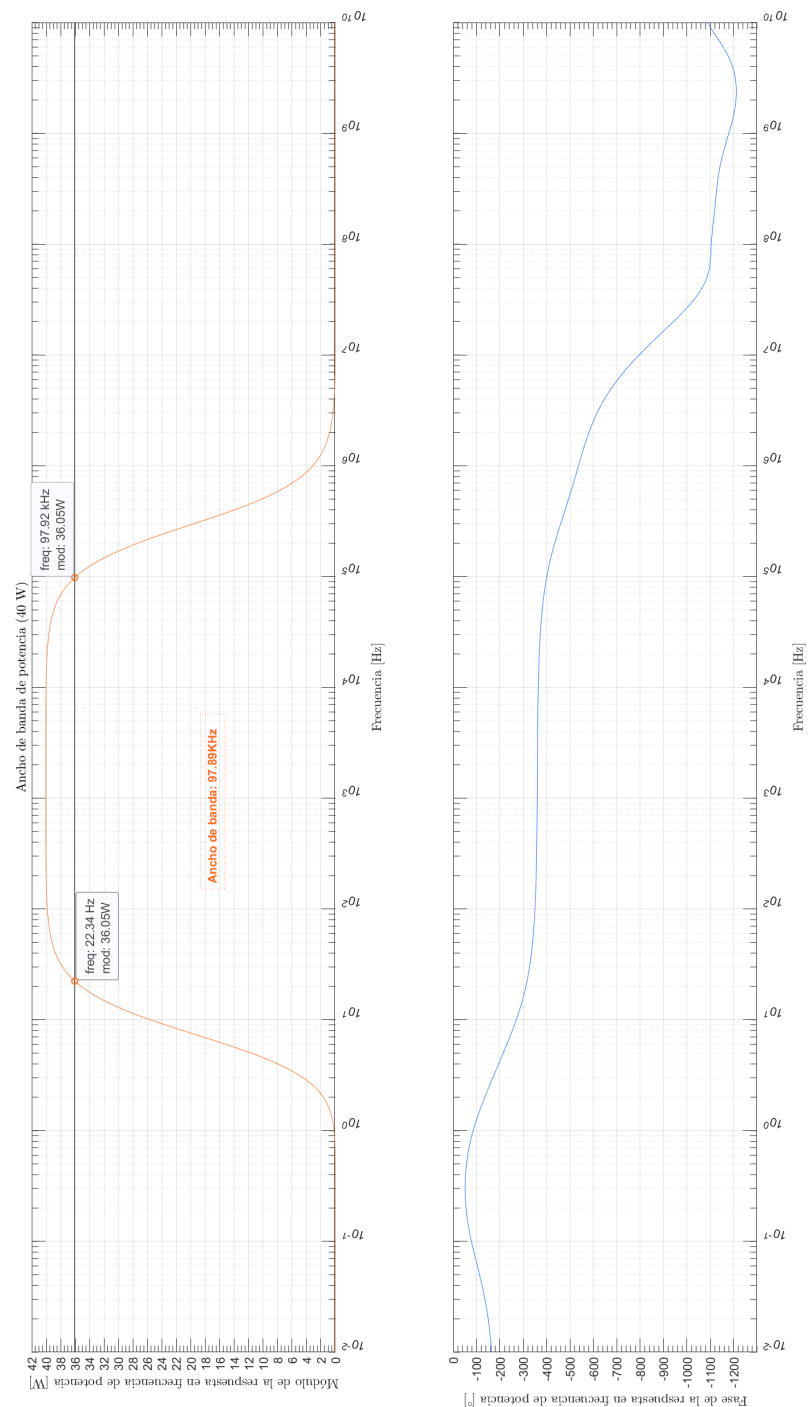


Figura 3.4: Ancho de banda de potencia (simulación).

3.5. Impedancias de entrada y salida

En las figuras [3.5] y [3.6], se observa los valores de la resistencia de entrada y salida del amplificador, respectivamente, en función de la frecuencia.

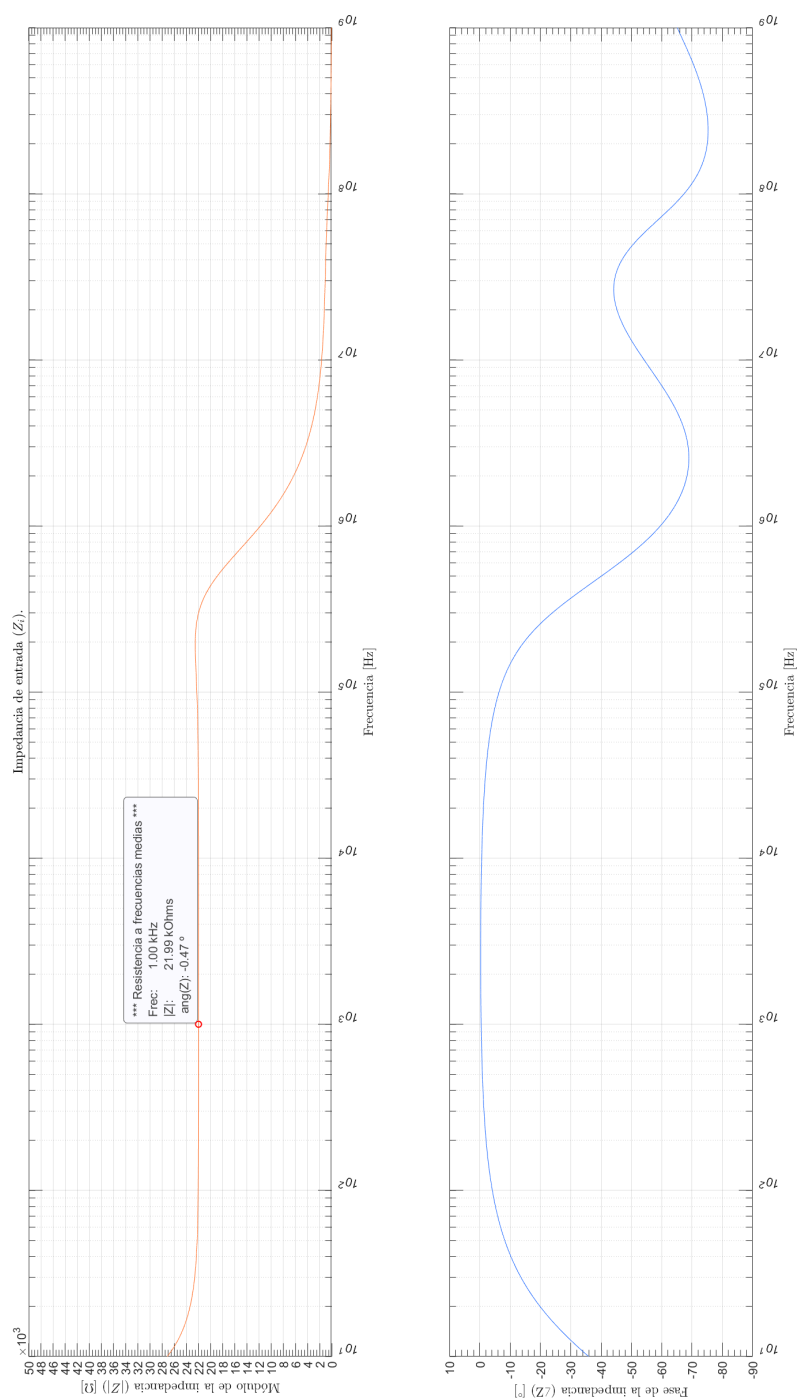


Figura 3.5: Valores de impedancia de entrada (simulación).

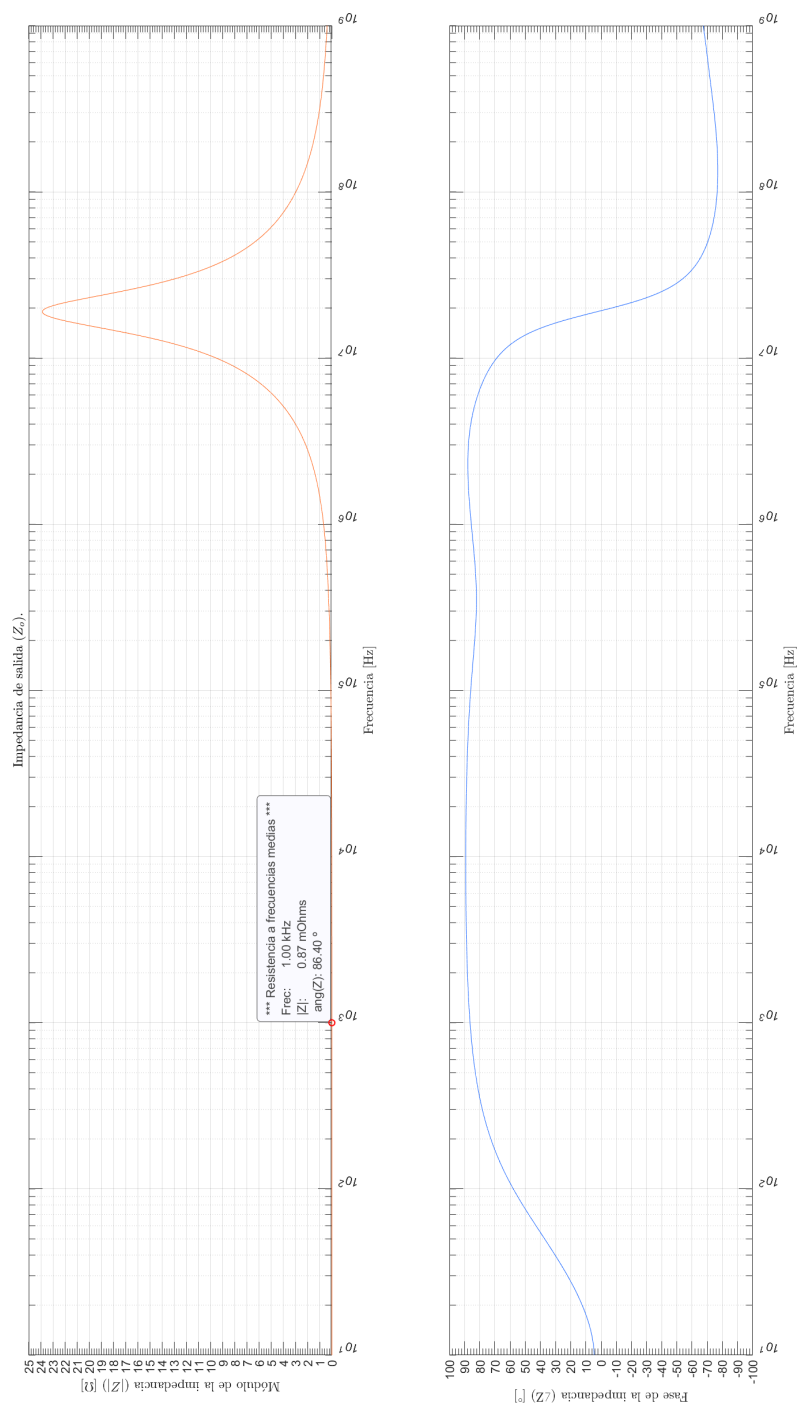


Figura 3.6: Valores de impedancia de salida (simulación).

3.6. THD

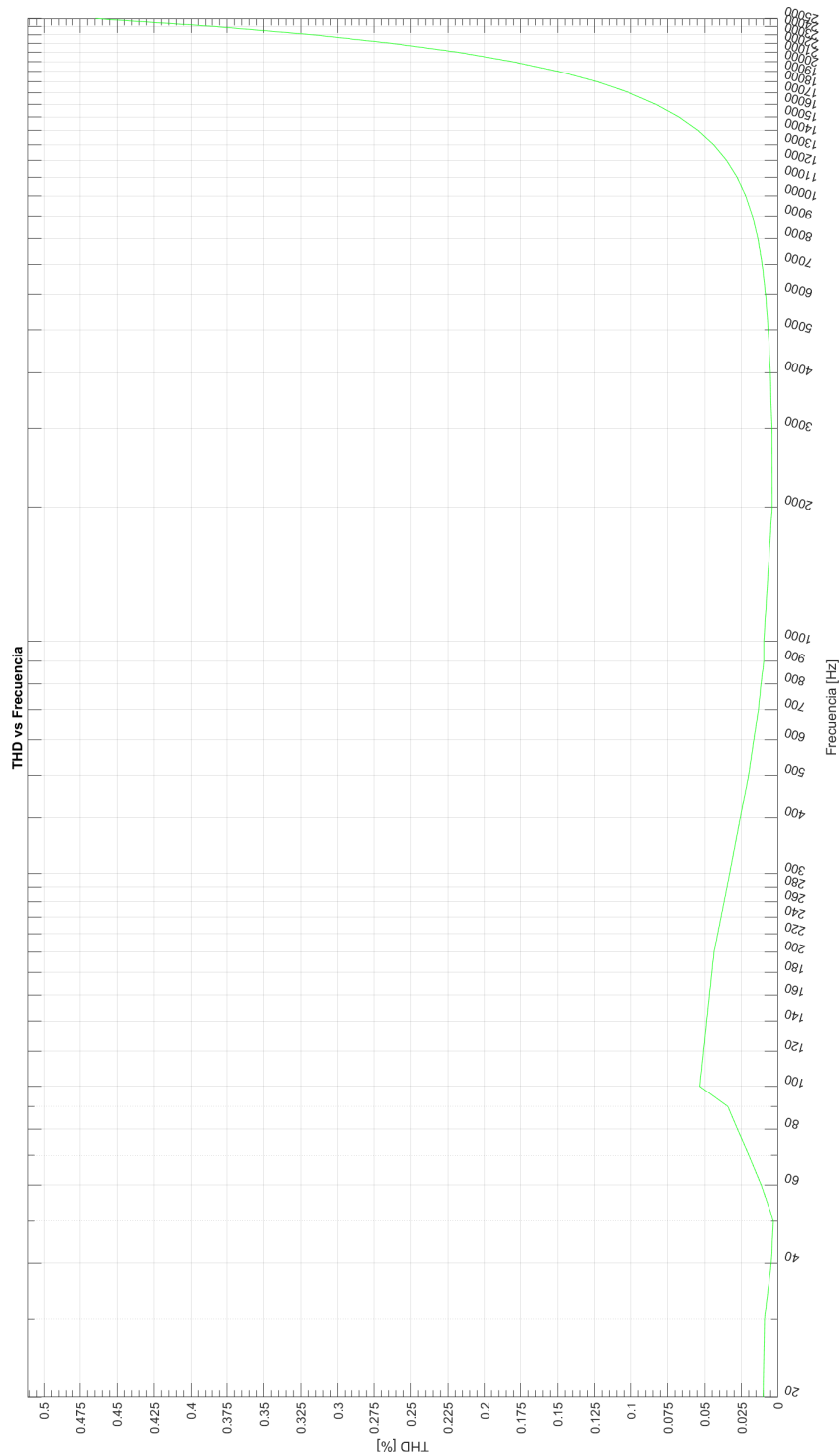


Figura 3.7: THD en función de la frecuencia (simulación).

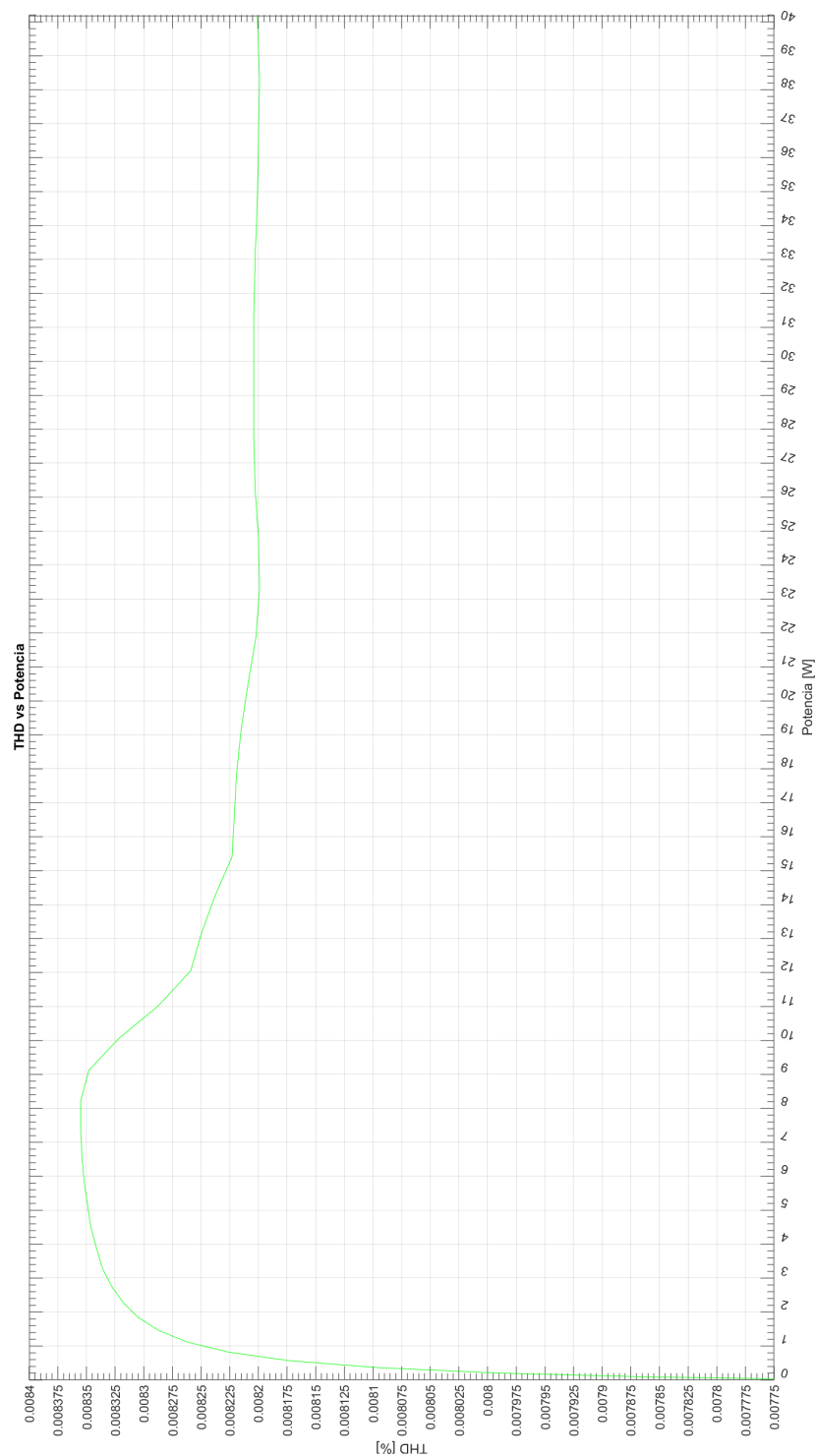


Figura 3.8: THD en función de la potencia (simulación).

3.7. Slew Rate

En la figura [3.9] observamos el resultado de la simulación utilizada para el cálculo del Slew Rate. En la figura [3.10], se aprecia con más claridad la pendiente para el cálculo, además del efecto que produce la conmutación entre las fuentes de 15V y 35V.

A partir del cálculo de la pendiente producida por la respuesta al escalón obtenemos como resultado del Slew Rate:

- Slew Rate = $4,79\text{V}/\mu\text{s}$

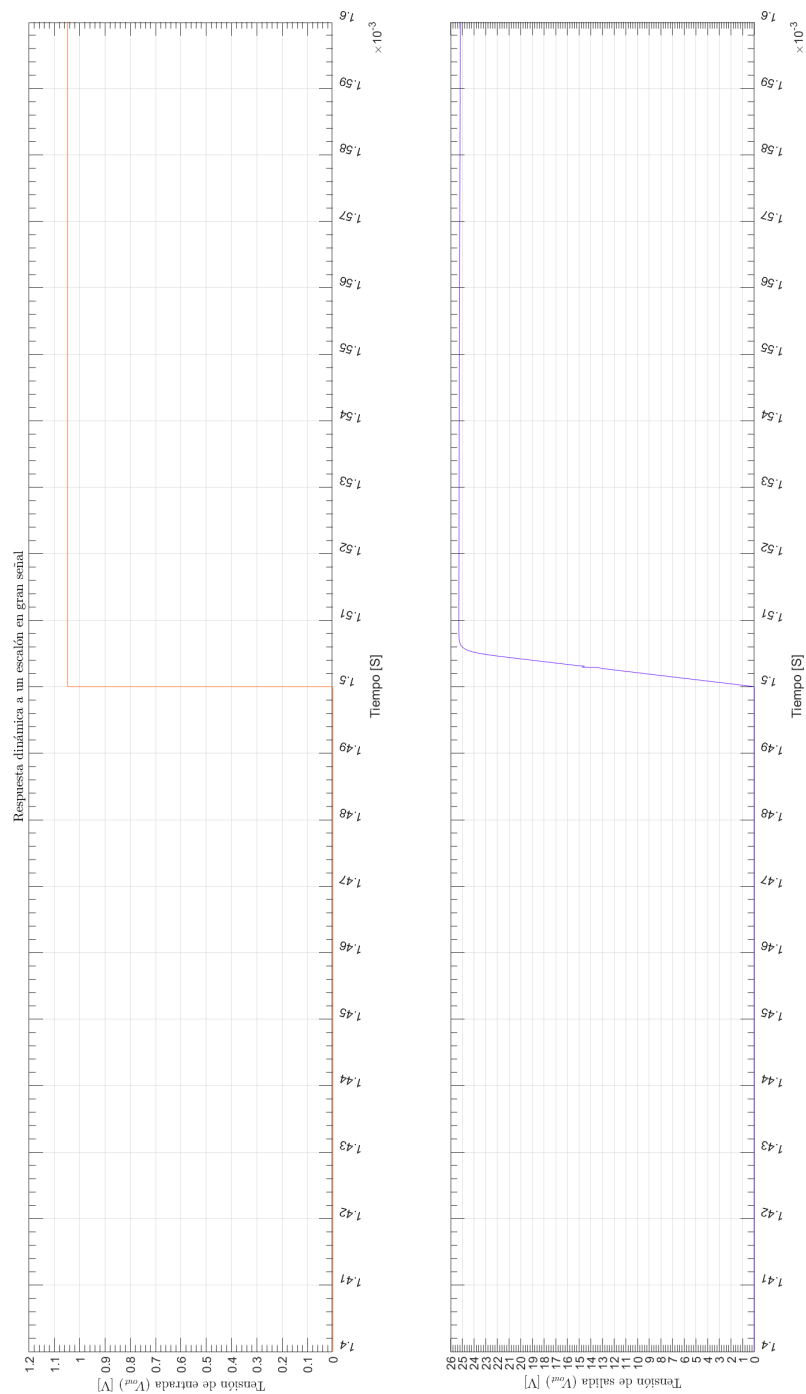


Figura 3.9: Tiempo de crecimiento (simulación).

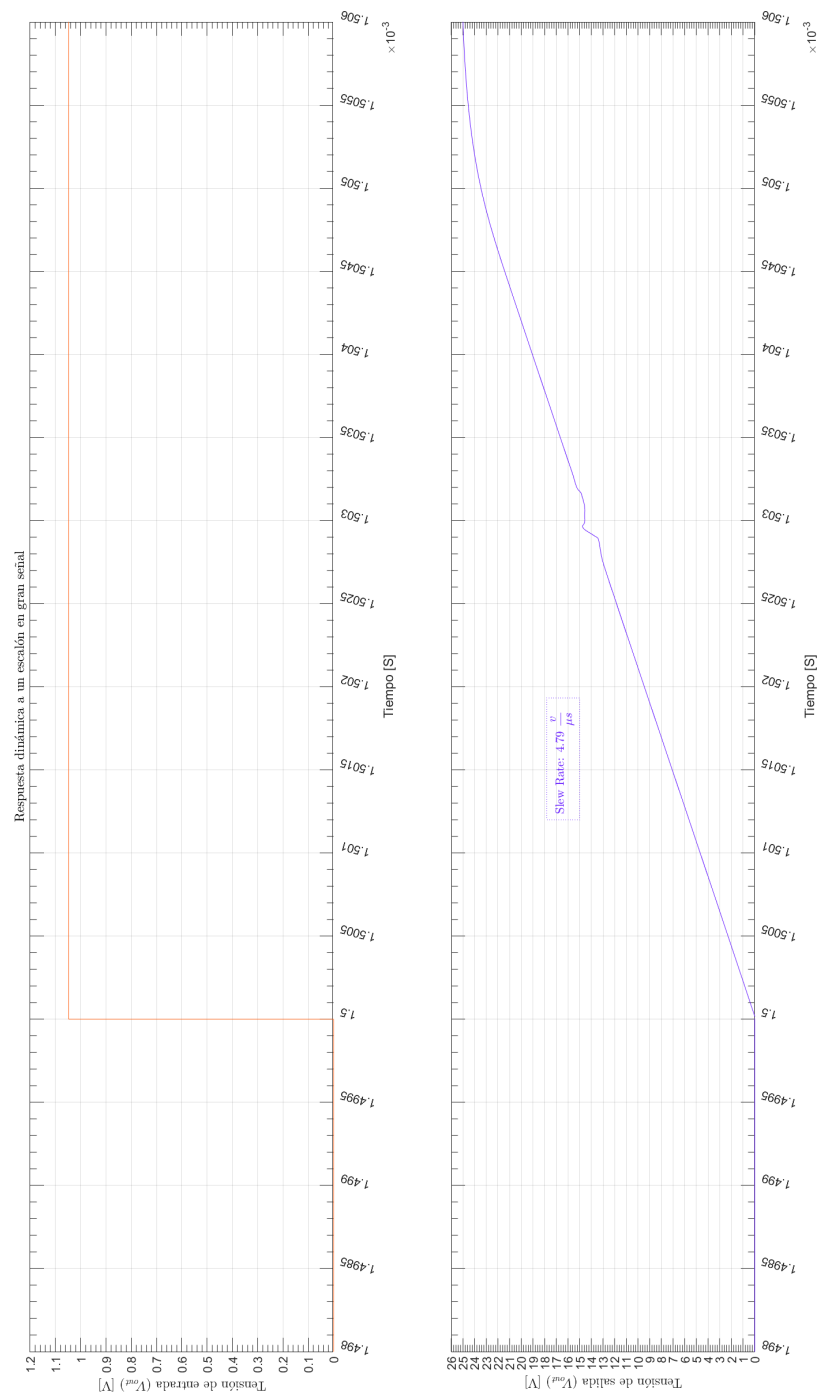


Figura 3.10: Tiempo de crecimiento, zoom sobre la pendiente (simulación).

4. Mediciones

4.1. Polarización

Se realizaron las mediciones de punto de polarización del amplificador sin señal aplicada, obteniéndose los resultados del cuadro [4.1]. Los mismos se verificaron con y sin la carga conectada para observar que no haya cambios en la polarización, una vez ajustada la corriente de polarización de salida, para este primer caso se ajustó la corriente de los transistores de salida en aproximadamente 190mA. El segundo caso medido se muestra en el cuadro [4.2], en este caso se ajustó la corriente al máximo que permite el preset del multiplicador de V_{BE} , aproximadamente 700mA, como puede observarse en este caso la potencia disipada en reposo es considerable, unos 22W, pero puede verse como las primeras etapas prácticamente no se ven afectadas por el cambio en la corriente de reposo de los transistores de salida.

Transistor	V_{CEQ}	I_{CQ}	P_Q
Q_1 (BC546C)	33,87V	548,76μA	18,57mW
Q_2 (BC556B)	1,31V	548,76mA	718,88μW
Q_3 (BC546B)	31,78V	1,1mA	34,96mW
Q_4 (BC556B)	610,56mV	548,56μA	334,93μW
Q_5 (BC546B)	34,58V	548,56μA	18,97mW
Q_6 (BC546B)	29,02V	9,71mA	281,78mW
Q_7 (BC556B)	30,32V	169,17μA	5,13mW
Q_8 (BC556B)	30,86V	9,55mA	295,55mW
Q_9 (BD135)	2,71V	9,46mA	25,64mW
Q_{10} (BD136)	14,09V	8,28mA	116,67mW
Q_{11} (BD136)	20,26V	0mA	0mW
Q_{12} (BD135)	20,27V	0mA	0mW
Q_{13} (BD135)	14,06V	9,7mA	136,38mW
Q_{14} (MJL21194)	20,27V	0mA	0mW
Q_{15} (MJL21194)	14,72V	192,02mA	2,83W
Q_{16} (MJL21193)	14,71V	193,5mA	2,85W
Q_{17} (MJL21193)	20,26V	0mA	0mW
Q_{18} (2N3906)	1,36V	0mA	0mW
Q_{19} (2N3904)	1,35V	0mA	0mW

Cuadro 4.1: Primer punto de operación.

Transistor	V_{CEQ}	I_{CQ}	P_Q
Q_1 (BC546C)	33,87V	548,76μA	18,57mW
Q_2 (BC556B)	1,31V	548,76mA	718,88μW
Q_3 (BC546B)	31,78V	1,1mA	34,96mW
Q_4 (BC556B)	610,56mV	548,56μA	334,93μW
Q_5 (BC546B)	34,58V	548,56μA	18,97mW
Q_6 (BC546B)	28,79V	9,71mA	279,55mW
Q_7 (BC556B)	30,05V	169,4μA	5,09mW
Q_8 (BC556B)	30,72V	9,57mA	294mW
Q_9 (BD135)	2,95V	9,40mA	27,73mW
Q_{10} (BD136)	13,93V	14,73mA	205,19mW
Q_{11} (BD136)	20,32V	0mA	0mW
Q_{12} (BD135)	20,30V	0mA	0mW
Q_{13} (BD135)	13,89V	18,66mA	259,19mW
Q_{14} (MJL21194)	20,32V	0mA	0mW
Q_{15} (MJL21194)	14,62V	700,06mA	10,23W
Q_{16} (MJL21193)	14,61V	704,1mA	10,29W
Q_{17} (MJL21193)	20,32V	0mA	0mW
Q_{18} (2N3906)	1,47V	0mA	0mW
Q_{19} (2N3904)	1,48V	0mA	0mW

Cuadro 4.2: Segundo punto de operación.

4.2. Ancho de banda

Para la medición del ancho de banda, se buscaron las frecuencias de corte para una señal tal que sea el 10% de la potencia máxima de 40W especificada. Por lo tanto, se obtiene que la tensión de salida deberá tener un valor de $v_{out} = 8,9V$, y las frecuencias de corte se determinaran cuando $v_{out} \approx 8,48V$.

Se pueden observar los resultados de la medición en el cuadro [4.3].

Frecuencia	V_{out}	P	Fase
10Hz	7,2V	3,24W	38,9°
17,32Hz	8,4V	4,41W	23,13°
100Hz	8,9V	5W	-
1kHz	8,9V	5W	-
10kHz	8,9V	5W	-
42,3kHz	8,4V	4,41W	0,12°
100kHz	8V	4W	29,52°

Cuadro 4.3: Valores significativos del ancho de banda a baja potencia.

En el cuadro [4.4] se comparan los ancho de banda obtenidos por simulación, los medidos y los especificados:

Valor	Especificación	Simulación	Medición
f_l	10Hz	22,34Hz	17,32Hz
f_h	50kHz	97,92kHz	42,3kHz

Cuadro 4.4: Comparación de ancho de banda a baja potencia

En la figura [4.1] se muestra la medición para el valor de f_l para baja potencia, y en las figuras [4.2] y [4.3], se muestran las mediciones para el cálculo de la fase de corrimiento de las señales.

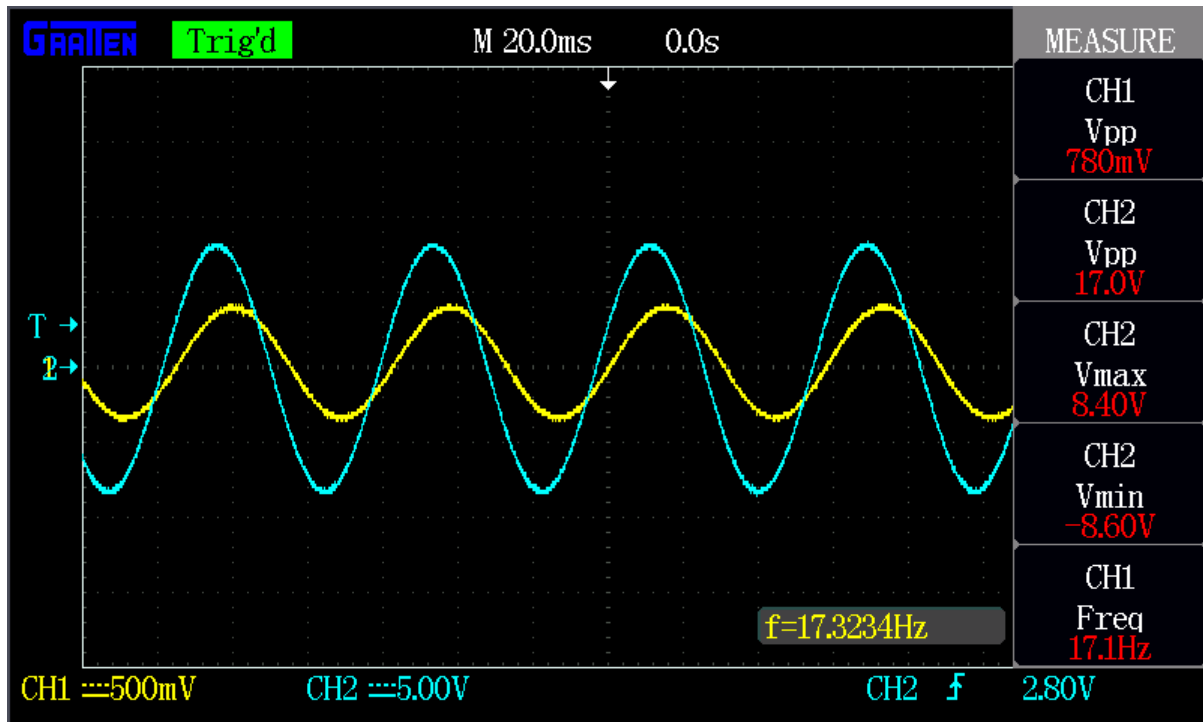


Figura 4.1: Medición de f_l a baja potencia, mostrando el corrimiento de fase.

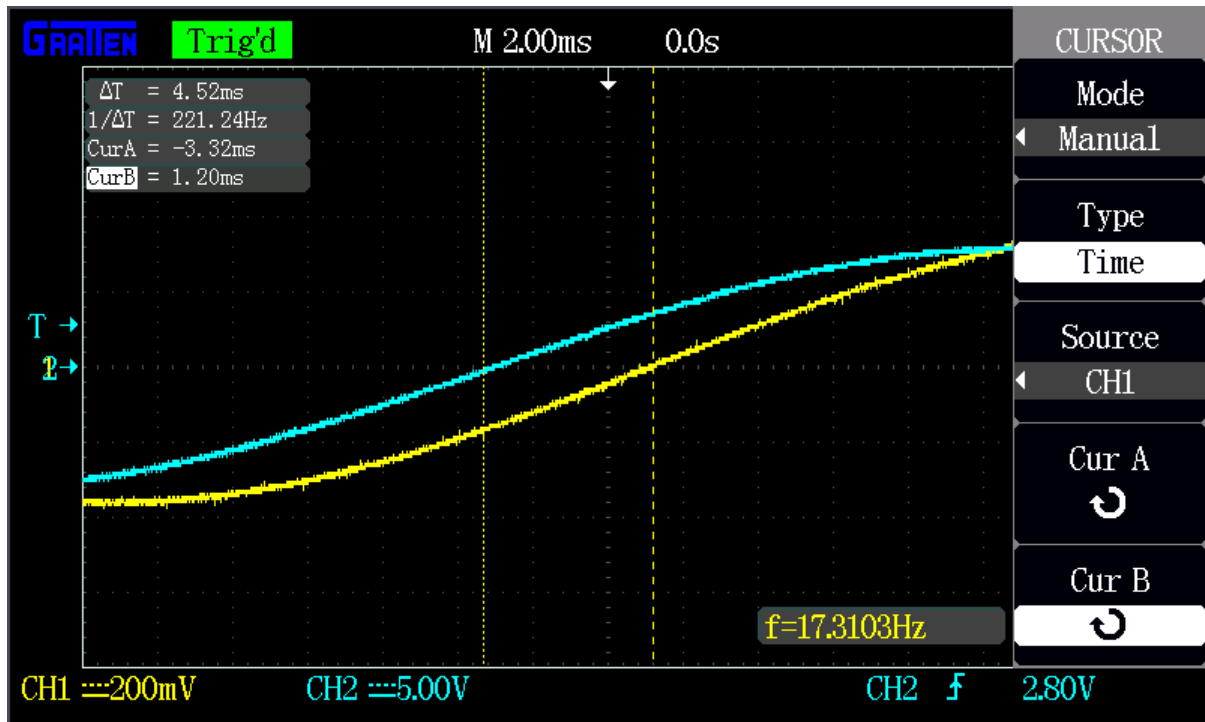


Figura 4.2: Cálculo del corrimiento de fase para f_l a baja potencia.



Figura 4.3: Cálculo del corrimiento de fase para f_h a baja potencia.

4.3. Ancho de banda de potencia

Para el caso del ancho de banda de potencia, se repite el procedimiento de la sección anterior pero con una señal de salida $V_{out} = 25,3V$ a máxima potencia (40W). En este caso, las frecuencias de corte se determinan cuando $V_{out} = 24V$.

Se pueden observar los resultados de la medición en el cuadro [4.5].

Frecuencia	V_{out}	P	Fase
10Hz	20,8V	27,09W	49,32°
19,75Hz	24V	4,41W	24,56°
100Hz	25,3V	5W	-
1kHz	25,3V	5W	-
10kHz	25,3V	5W	-
37,54kHz	24V	4,41W	23,09°

Cuadro 4.5: Valores significativos del ancho de banda a máxima potencia.

En el cuadro [4.6] se comparan los anchos de banda obtenidos por simulación, los medidos y los especificados:

Valor	Especificación	Simulación	Medición
f_l	—	22,34Hz	19,75Hz
f_h	30kHz	97,84kHz	37,54kHz

Cuadro 4.6: Comparación de ancho de banda a máxima potencia

En las figuras [4.4] y [4.5], se muestran las mediciones para el cálculo de la fase de corrimiento de las señales.

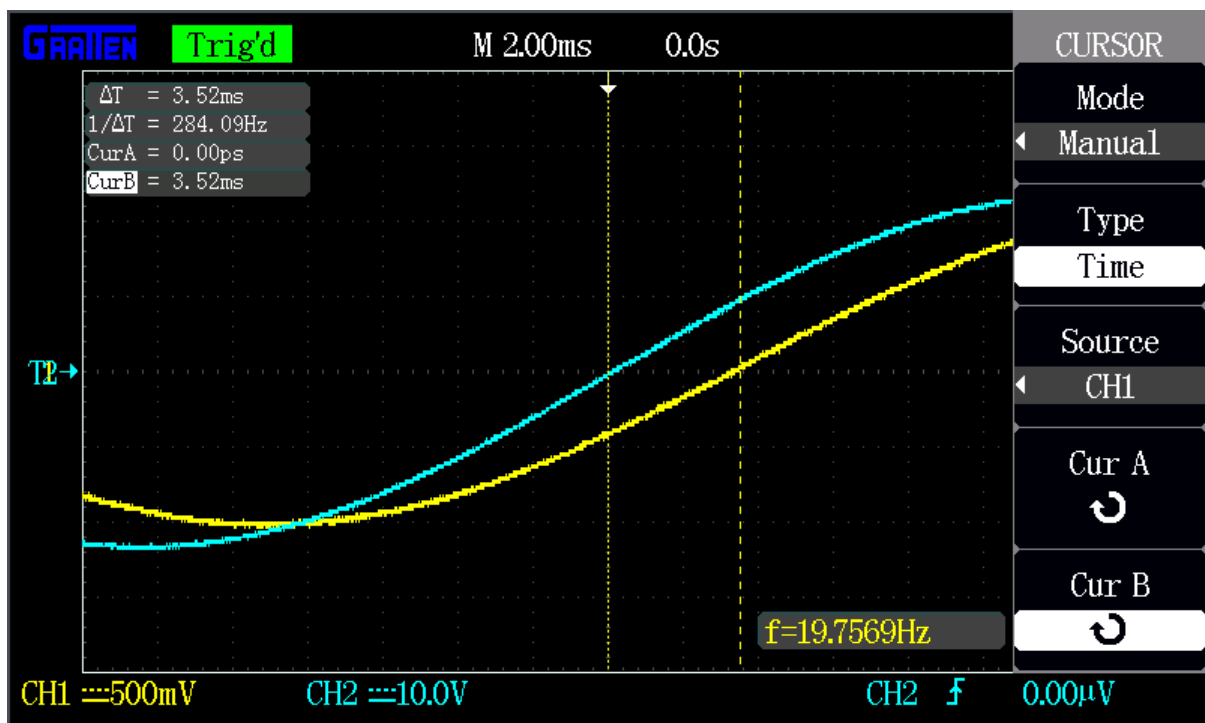


Figura 4.4: Medición de f_l a máxima potencia, mostrando el corrimiento de fase.

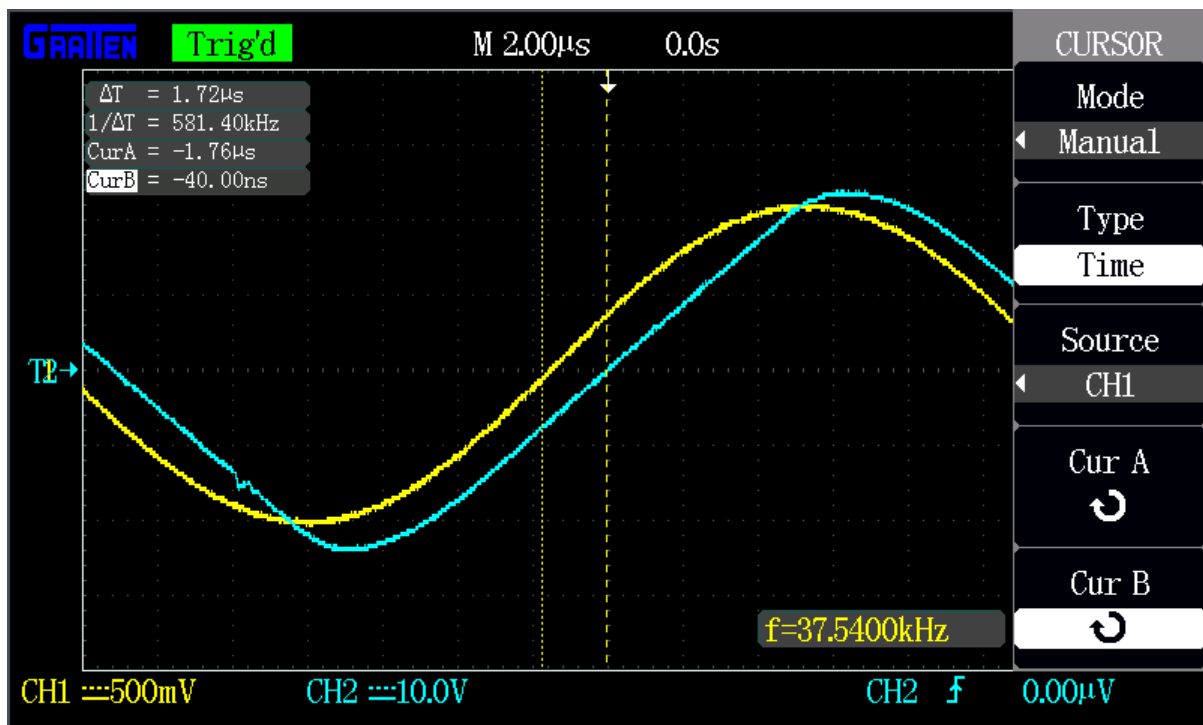


Figura 4.5: Medición de f_l a máxima potencia, mostrando el corrimiento de fase.

4.4. Sensibilidad

Se midió el valor eficaz de una señal senoidal de 1kHz aplicada a la entrada $v_{in} = 1,08V$, que produce la potencia especificada a la salida con carga nominal, siendo esta última $v_{out} = 25,2V$. Se verifica dicha medición en la figura [4.6].

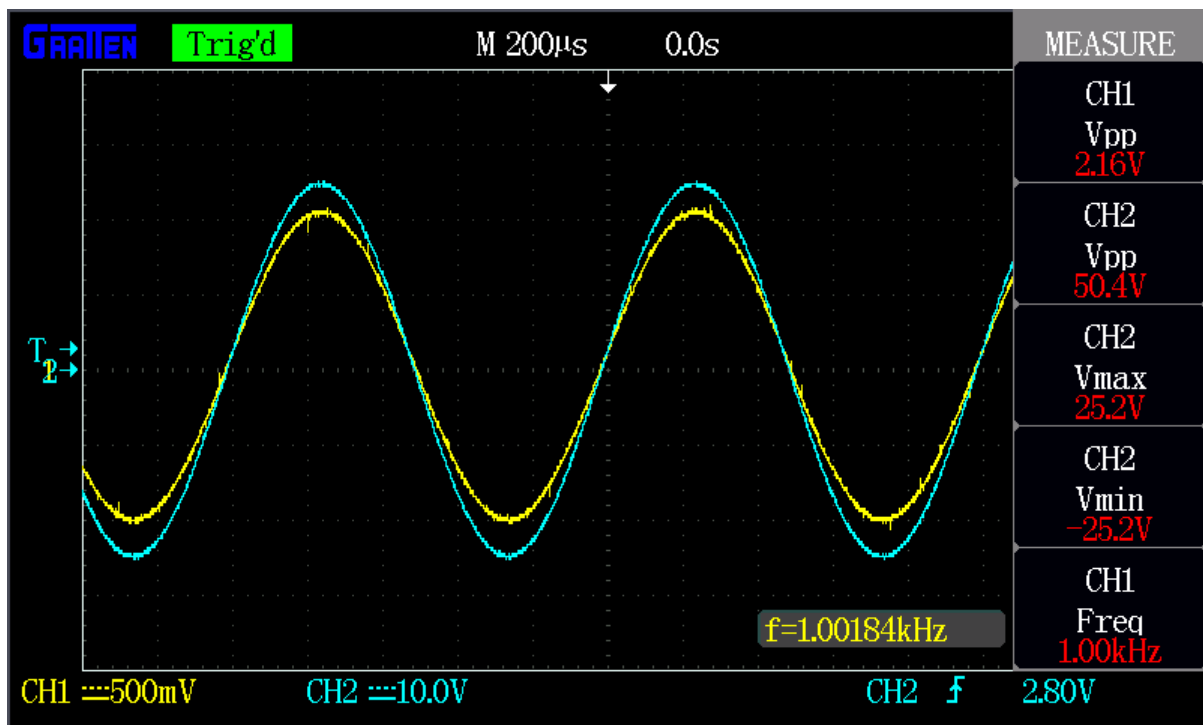


Figura 4.6: Medición de la sensibilidad del circuito amplificador.

4.5. THD

4.6. Slew Rate

Se aplicó una señal cuadrada de máxima potencia a modo de obtener el valor numérico del SR, calculando la pendiente de la recta obtenida en la figura [4.8]. Antes, se verificó en la figura [4.7] que el tiempo de crecimiento de la fuente generadora de señal sea lo suficientemente baja para poder garantizar una correcta medición, siendo este tiempo de $\tau = 264\text{ns}$.

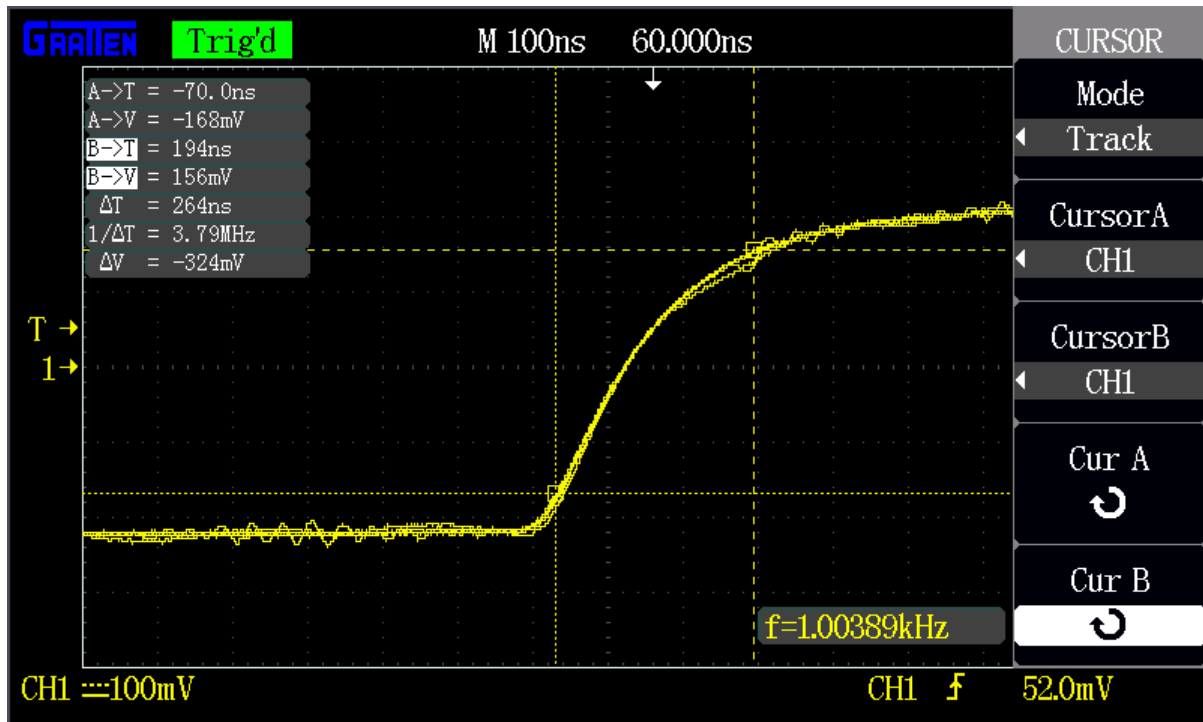


Figura 4.7: Verificación de tiempo de crecimiento del generador.

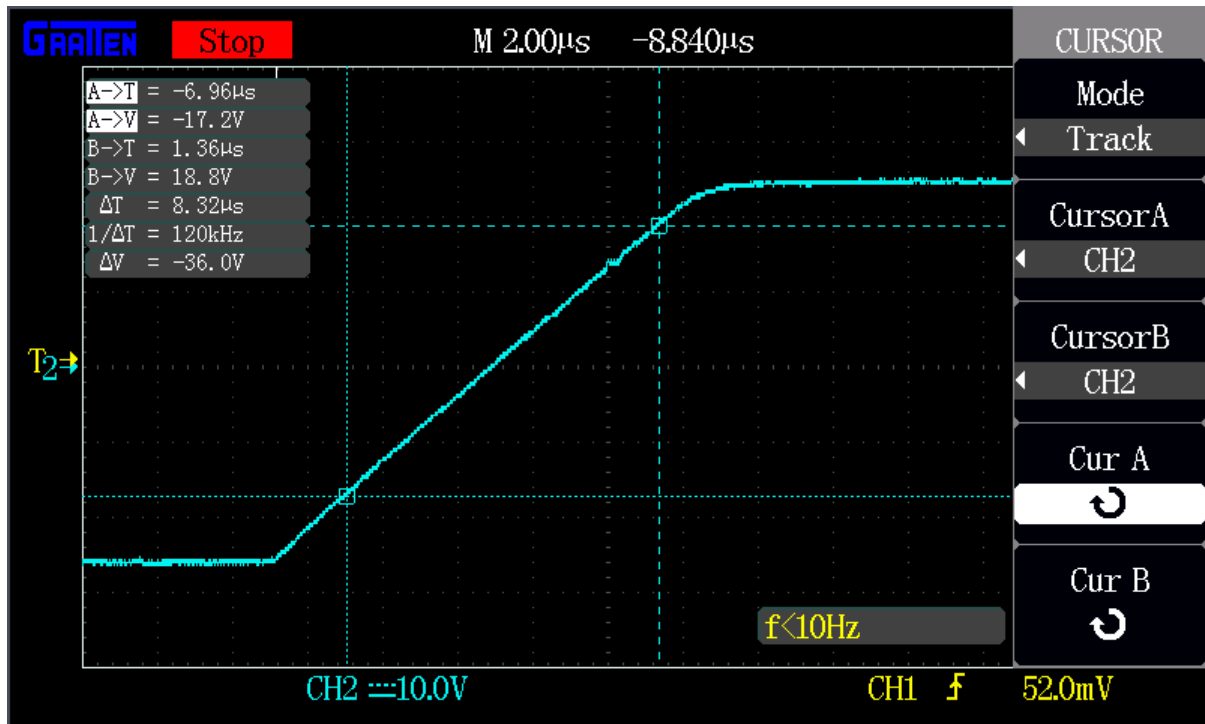


Figura 4.8: Medición del Slew Rate del circuito amplificador.

Mediante el cálculo pertinente, y comparando con las simulaciones, se obtiene el cuadro comparativo [4.7]:

Valor	Especificación	Simulación	Medición
<i>Slew Rate</i>	5V/μs	4,79V/μs	4,32V/μs

Cuadro 4.7: Comparación del Slew Rate.

5. Observaciones y conclusiones

6. Bibliografía

Referencias

- [1] *Analysis and Design of Analog Integrated Circuits (3rd Edition)*
Author: Paul R. Gray
Author: Robert G. Meyer
Publisher: John Wiley & Sons, Inc.; 3rd Edition (January 15, 1993)
Copyright: © 1993, John Wiley & Sons, Inc.
ISBN 10: 0471574953
Website: [Analysis and Design of Analog Integrated Circuits \(3rd Edition\)](#)
- [2] *Analysis and Design of Analog Integrated Circuits (4th Edition)*
Author: Paul R. Gray
Author: Paul J. Hurst
Author: Stephen H. Lewis
Author: Robert G. Meyer
Publisher: John Wiley & Sons, Inc.; 4th Edition (2001)
Copyright: © 2001, John Wiley & Sons, Inc.
ISBN 10: 0471321680
ISBN 13: 9780471321682
Website: [Analysis and Design of Analog Integrated Circuits \(4th Edition\)](#)
- [3] *Analysis and Design of Analog Integrated Circuits (5th Edition)*
Author: Paul R. Gray
Author: Paul J. Hurst
Author: Stephen H. Lewis
Author: Robert G. Meyer
Publisher: John Wiley & Sons, Inc.; 5th Edition (2009)
Copyright: © 2001, John Wiley & Sons, Inc.
ISBN 10: 0470245999
ISBN 13: 9780470245996
Website: [Analysis and Design of Analog Integrated Circuits \(5th Edition\)](#)

- [4] *Circuitos microelectrónicos (4^{ta} Edición) español*

Author: Adel. S. Sedra

Author: Kenneth C. Smith

Publisher: Oxford, University press; 4^{ta} Edición (2001)

Copyright: © 1999, Oxford, University press México.

Original Copyright: © 1998, 1991, 1987, 1982, Oxford, University press Inc.

ISBN 10: 01951166310

Website: [Circuitos microelectrónicos \(4^{ta} Edición\) español](#)

- [5] *Microelectronic circuits (5th Edition)*

Author: Adel. S. Sedra

Author: Kenneth C. Smith

Publisher: Oxford, University press; 5th Edition (2004)

Copyright: © 2004, 1998, 1991, 1987, 1982, Oxford, University press Inc.

ISBN 10: 0195142527

Website: [Microelectronic circuits \(5th Edition\)](#)

- [6] *AUDIO POWER AMPLIFIER DESIGN HANDBOOK (5th Edition)*

Author: Douglas Self

Publisher: Elsevier Ltd; 5th Edition (2009)

Copyright: © 2009, Douglas Self. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.

ISBN 13: 9780240521626

Website: [AUDIO POWER AMPLIFIER DESIGN HANDBOOK \(5th Edition\)](#)

Apéndices

A. Hojas de datos

A.1. BD135

NPN Plastic Medium-Power Silicon Transistors

Manufacturer page: <https://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=BD135>

Manufacturer Datasheet: <https://www.onsemi.com/pub/Collateral/BD135-D.PDF>

A.2. BD136

PNP Plastic Medium-Power Silicon Transistors

Manufacturer page: <https://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=BD136>

Manufacturer Datasheet: <https://www.onsemi.com/pub/Collateral/BD136G-D.PDF>

A.3. BC556

PNP Silicon Transistor

Manufacturer page: <https://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=BC556>

Manufacturer Datasheet: <https://www.onsemi.com/pub/Collateral/BC556BTA-D.pdf>

A.4. MJL21193

PNP Bipolar Power Transistor

Manufacturer page: <https://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=MJL21193>

Manufacturer Datasheet: <https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MJL21193-D.PDF>

A.5. MJL21194

NPN Bipolar Power Transistor

Manufacturer page: <https://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=MJL21194>

Manufacturer Datasheet: <https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MJL21193-D.PDF>

A.6. 1N4148

Small signal diode

Manufacturer page: <https://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=1N4148>

Manufacturer Datasheet: <https://www.vishay.com/docs/81857/1n4148.pdf>

A.7. 1N4370

Zener Voltage Regulator Diode

Manufacturer page: <https://www.microsemi.com/existing-parts/parts/121321>

Manufacturer Datasheet: http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/microsemi/1N746_759A_4370_4372A.pdf

A.8. 1N4007

Silicon rectifier diode

Manufacturer page: <https://www.onsemi.com/products/discretes-drivers/diodes-rectifiers/rectifiers/1n4007>

Manufacturer Datasheet: <http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/fairchild/1N4007.pdf>

A.9. 1N5822

Schottky Barrier Rectifier

Manufacturer page: <https://www.onsemi.com/products/discretes-drivers/diodes-rectifiers/schottky-diodes-schottky-rectifiers/1n5822>

Manufacturer Datasheet: <https://www.onsemi.com/pub/Collateral/1N5820-D.PDF>

A.10. Metal film resistor

Metal film resistor

Manufacturer page: <https://www.vishay.com/resistors-fixed/metal-film/tab/doclibrary/>

A.11. Carbon film resistor

Carbon film resistor

Manufacturer page: <http://www.vishay.com/resistors-fixed/carbon-film/tab/doclibrary/>

A.12. Ceramic capacitor

Ceramic disk capacitor

Manufacturer page: <https://www.vishay.com/capacitors/ceramic/disc/>

A.13. Electrolytic Aluminum capacitor

Electrolytic aluminum capacitor

Manufacturer page: <https://www.vishay.com/capacitors/aluminum/>